

# Verpolschutz mit „Idealer Diode“

Vortrag zum OV Abend, 2. September 2022

Matthias Ulmann, DK9MAT



# Ausgangspunkt

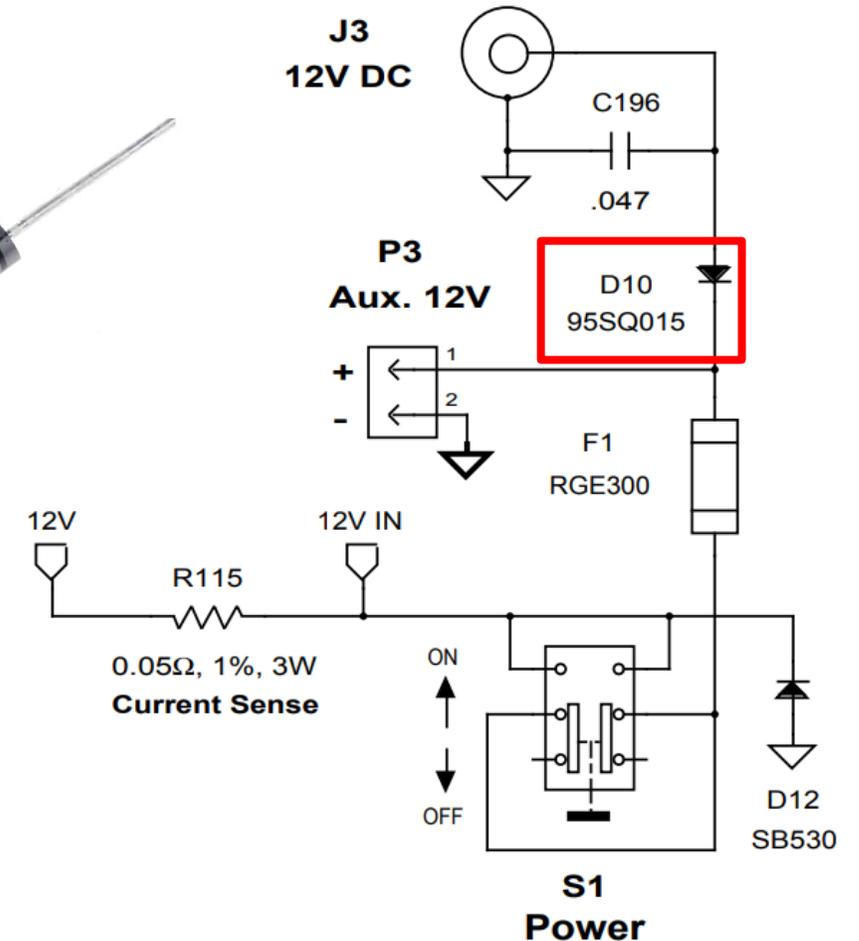
- Verpolschutz zum Schutz von Geräten vor versehentlich falsch herum angelegter Versorgungsspannung
- Möglichkeiten des Verpolschutzes
  - Mechanisch: Kontakte, Gehäuse
  - Elektrisch: Diode
- Mechanik kann sicher sein, muss aber nicht (Beispiel Hohlstecker)
- Eine Diode lässt Strom nur in eine Richtung fließen und man kann manuell nichts falsch machen  
→ Hört sich nach der idealen Lösung an, oder etwa nicht!?  
Im Prinzip ja, aber ...



# Beispiel Elecraft K2

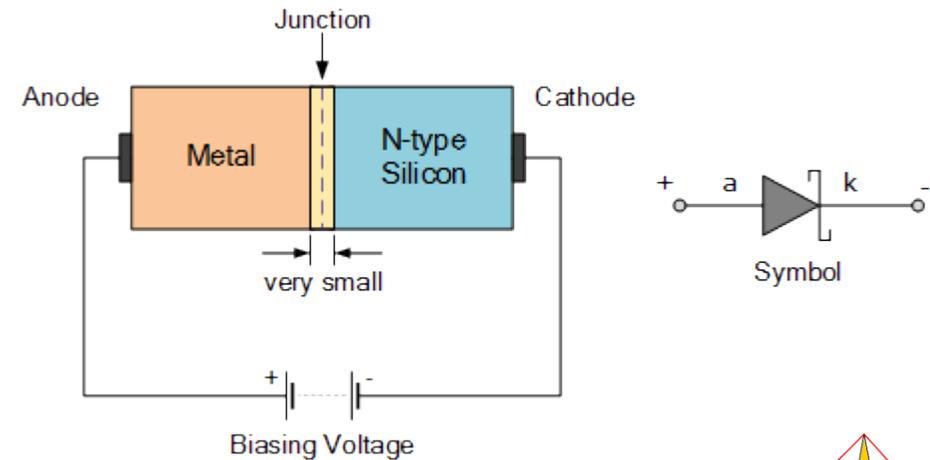
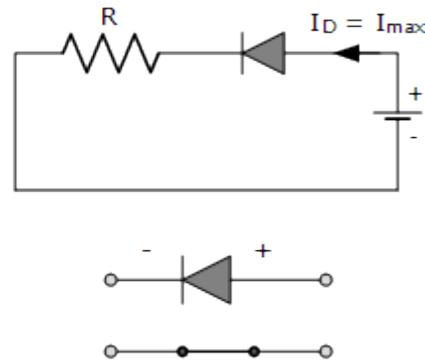
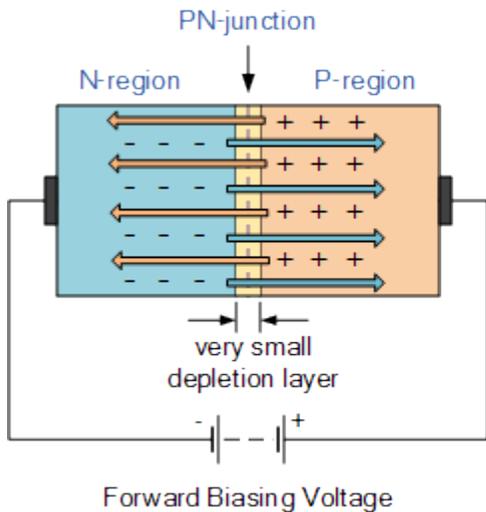
- Verpolschutz K2
  - Verpolschutzdiode 95SQ015
  - Versorgungsspannung 9 .. 15 V
  - Stromaufnahme ca. 2 A bei 10 W HF
- 95SQ015 Datenblatt
  - Schottky Diode
  - 15 V Sperrspannung
  - 9 A bei 50 % Duty Cycle @  $T_C = 55\text{ }^\circ\text{C}$

Was sagt uns das ...?



# Exkurs: Diode

	Halbleiterdiode	Schottky-Diode
Übergang	p-n (Halbleiter – Halbleiter)	Metall-Halbleiter
Vorwärtsspannung	ca. 0.7 V	typ. < 0.5 V
Max. Sperrspannung	sehr hoch (kV-Bereich)	< 250 V
Reverse recovery	ja → langsames Schalten	nein → schnelles Schalten



# Schottky-Diode 95SQ015

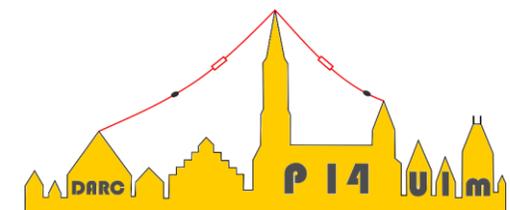
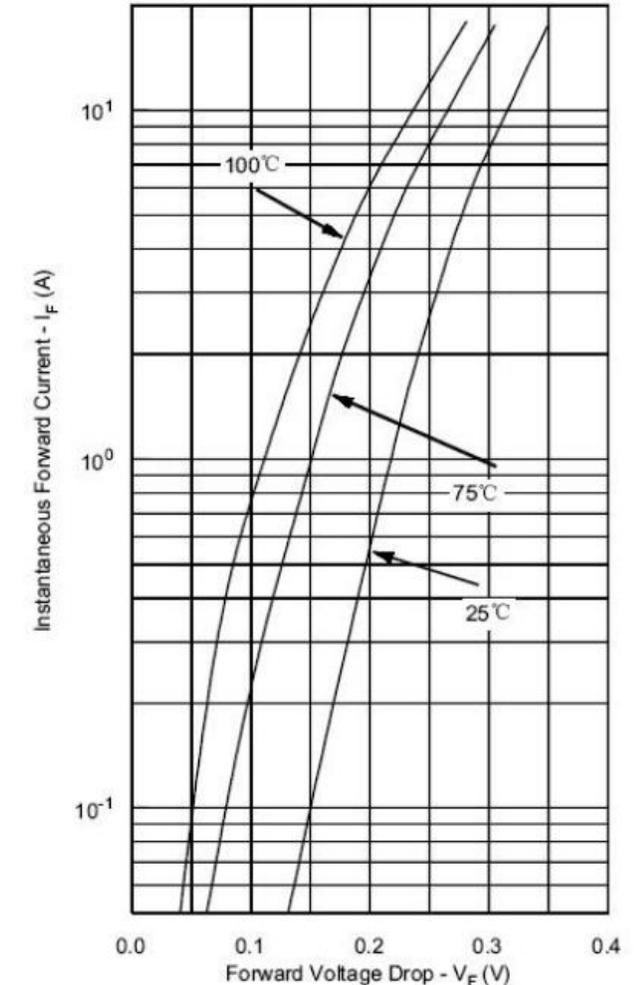
Characteristics	Symbol	Condition	Typ.	Max.	Units
Forward Voltage Drop*	$V_{F1}$	@ 9A, Pulse, $T_J = 25\text{ °C}$	0.31	0.34	V
		@ 18A, Pulse, $T_J = 25\text{ °C}$	0.35	0.37	
	$V_{F2}$	@ 9A, Pulse, $T_J = 125\text{ °C}$	0.22	0.25	V
		@ 18A, Pulse, $T_J = 125\text{ °C}$	0.28	0.31	

- Je niedriger der Strom, desto niedriger die Vorwärtsspannung  
→ Diode strommäßig überdimensionieren
- Je höher die Temperatur, desto niedriger die Vorwärtsspannung  
→ Signifikante Erwärmung im Betrieb kann vorteilhaft sein
- Je niedriger die Sperrspannung, desto niedriger die Vorwärtsspannung  
→ Diode spannungsmäßig nicht überdimensionieren

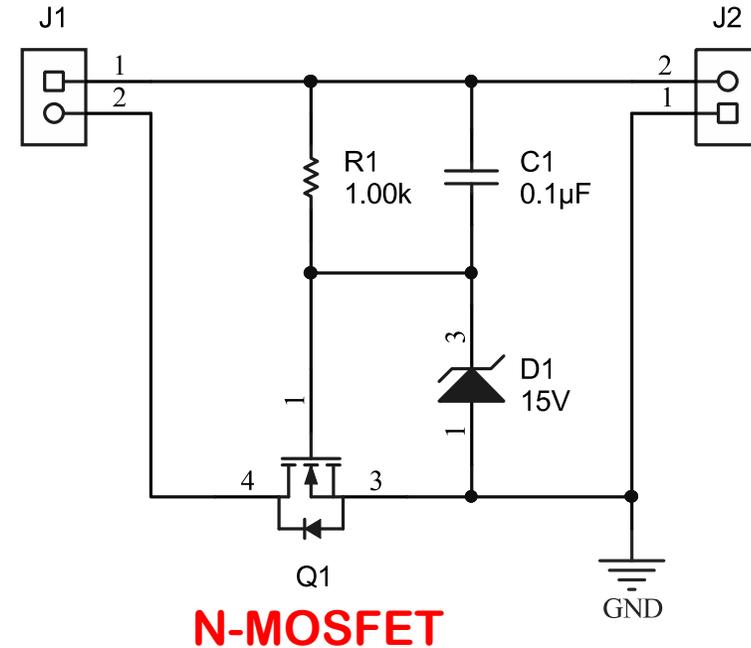
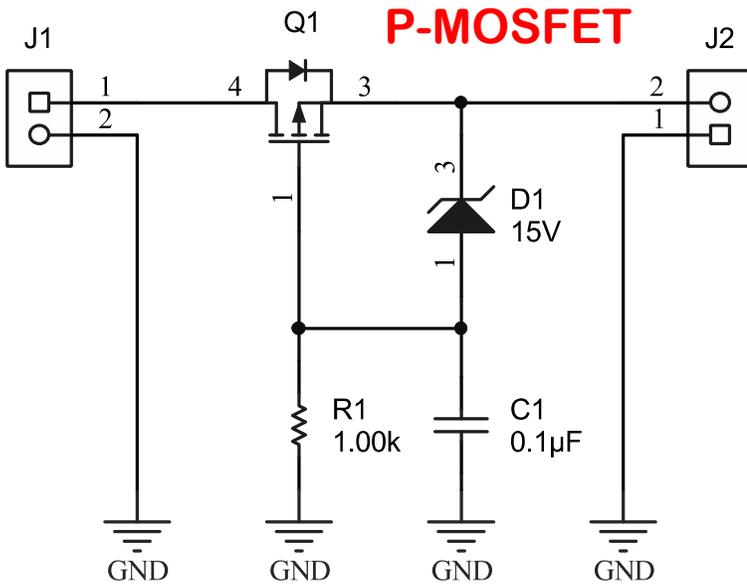
Temperatur	25 °C		100 °C	
	2 A	5 A	2 A	5 A
Vorwärtsstrom				
Vorwärtsspannung	240 mV	275 mV	140 mV	175 mV
Verluste	480 mW	1375 mW	280 mW	875 mW

Sieht bei 2 A nicht so dramatisch aus, aber geht es trotzdem besser?

Typical Forward Characteristics



# MOSFET als Alternative

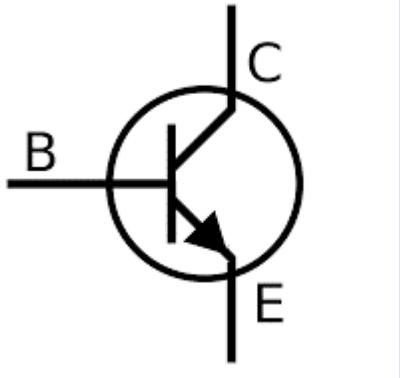
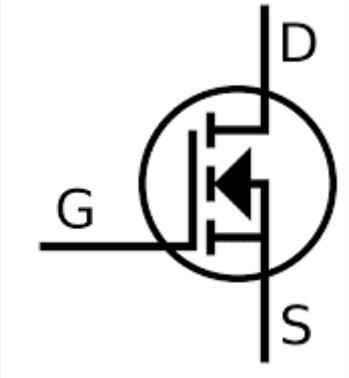


- „Leistungslose Ansteuerung“
- „Idealer Schalter“
- Und wie funktioniert der überhaupt ...?



# Exkurs: MOSFET 1/3

## Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor

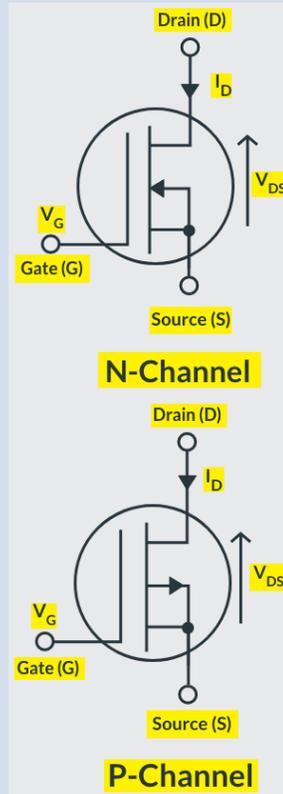
	Bipolartransistor	MOSFET
Ansteuerung	stromgesteuert → Basis-Emitter Strom	spannungsgesteuert → Gate-Source Spannung
Spannungsabfall	Kollektor-Emitter Spannung	$R_{DS,on} * I_D$
Symbol	 NPN	 N-MOSFET



# Exkurs: MOSFET 2/3

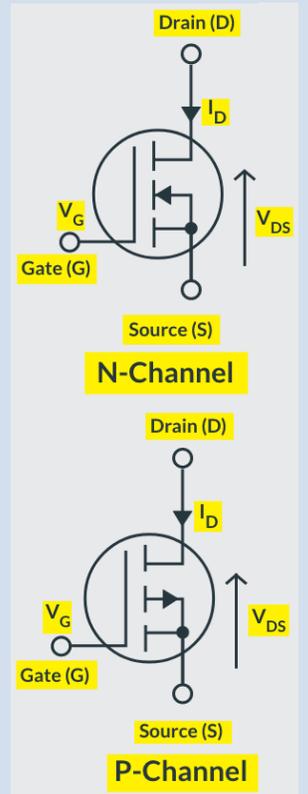
## Depletion Type / Verarmungstyp

- selbstleitend / normally-on
- ON
  - N-Kanal:  $V_G \geq V_S$
  - P-Kanal:  $V_G \leq V_S$
- OFF
  - N-Kanal:  $V_G \leq V_S - 3V^*$
  - P-Kanal:  $V_G \geq V_S + 3V^*$
- selten verwendet, z.B. in Anlaufschaltungen für Schaltnetzteile



## Enhancement Type / Anreicherungstyp

- selbstsperrend / normally-off
- ON
  - N-Kanal:  $V_G \geq V_S + 3V^*$
  - P-Kanal:  $V_G \leq V_S - 3V^*$
- OFF
  - N-Kanal:  $V_G \leq V_S$
  - P-Kanal:  $V_G \geq V_S$
- häufig verwendet, v.A. N-Kanal



\* 3V ist in vielen Fällen die max. Schwellspannung / Threshold  $V_{TH}$  des MOSFETs

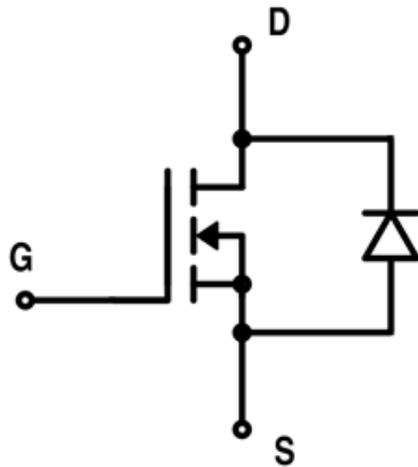


# Exkurs: MOSFET 3/3

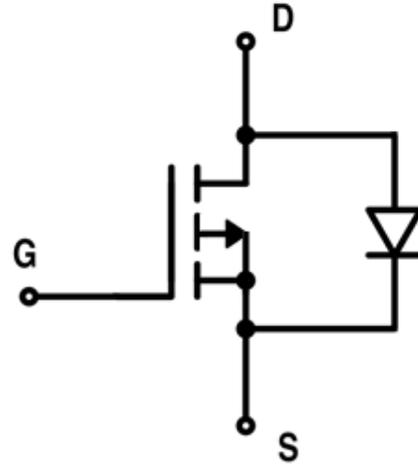
Noch zwei Punkte zum Schluß:

Nicht immer bekannt bzw. berücksichtigt, aber sehr wichtig!

## Body Diode

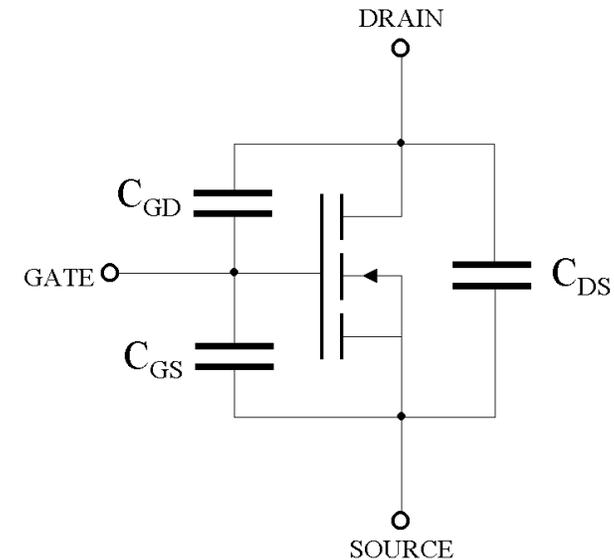


N MOS

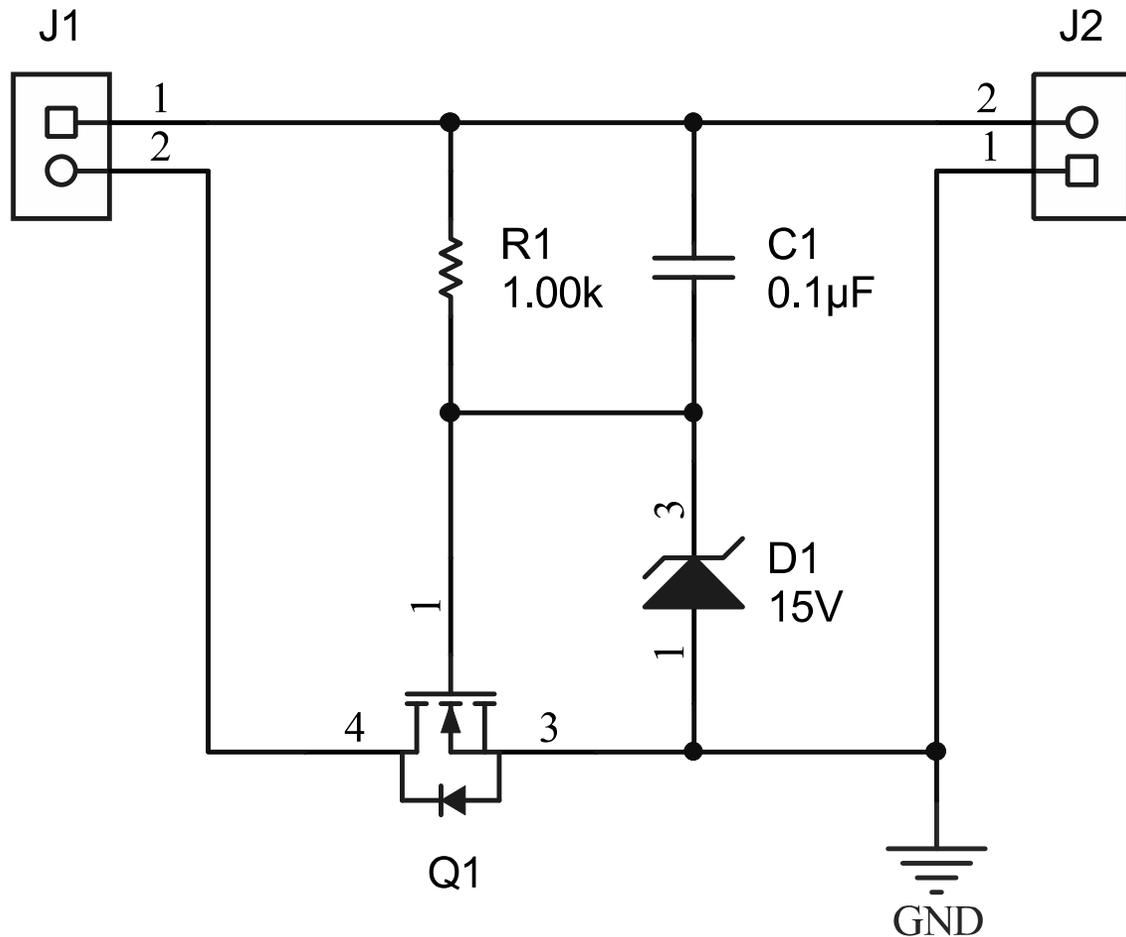


P MOS

## parasitäre Kapazitäten



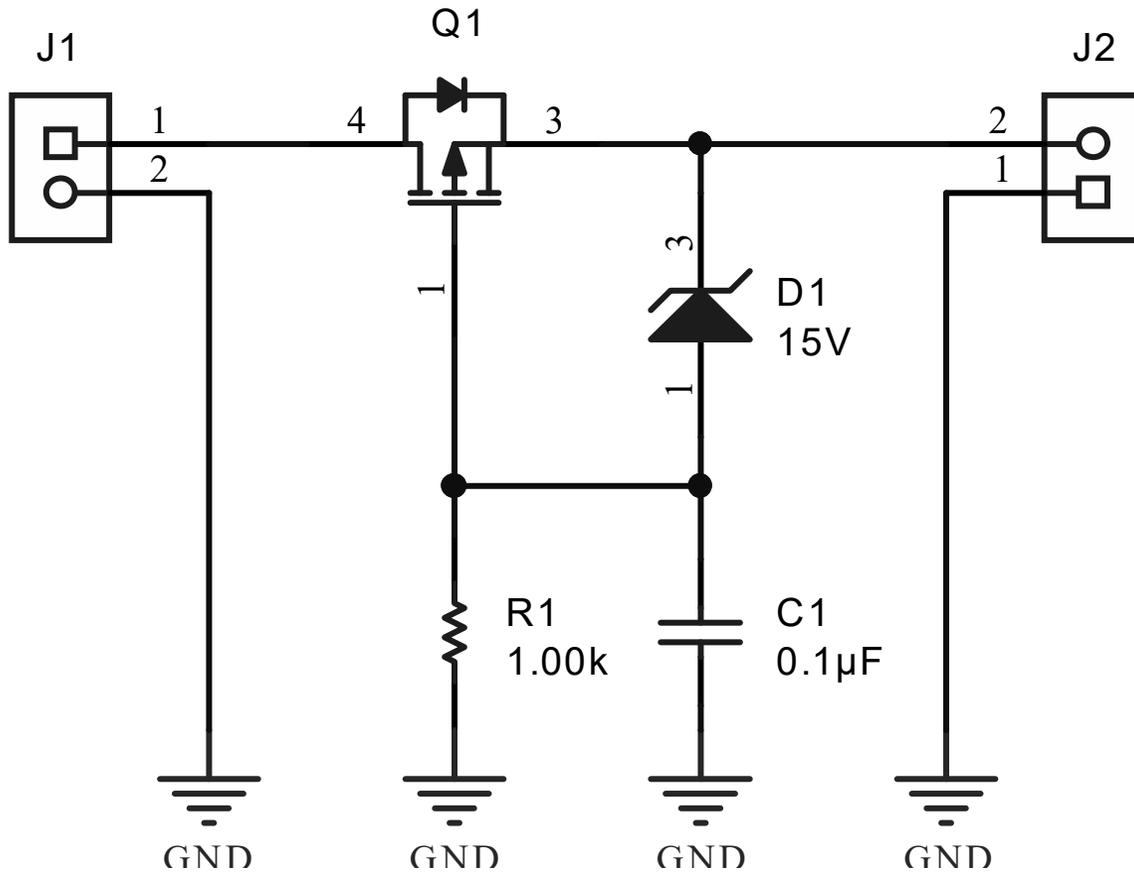
# N-MOSFET tiefliegend



- N-MOSFET als „ideale“ Diode
- Schaltet sich selbst an und aus
- D1 + R1 begrenzen Gate-Spannung
- Nachteil: Auftrennung von GND  
→ Nicht immer möglich



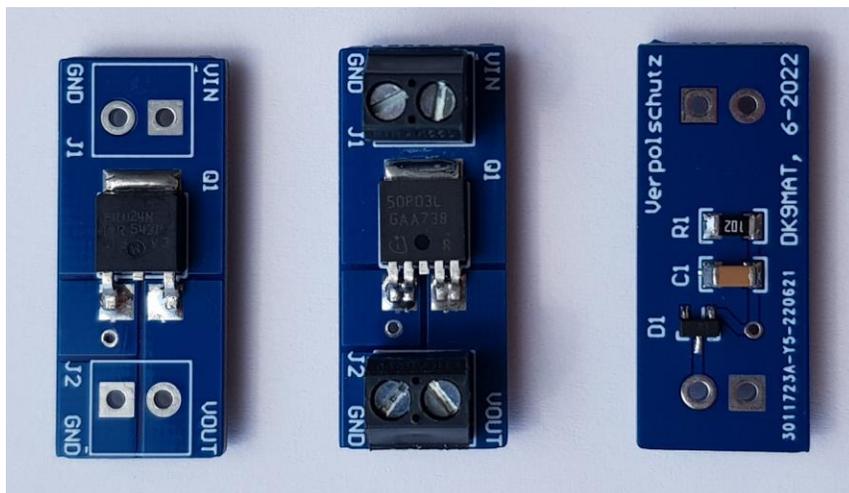
# P-MOSFET hochliegend 1/2



- P-MOSFET als „ideale“ Diode
- Schaltet sich selbst an und aus
- D1 + R1 begrenzen Gate-Spannung



# P-MOSFET hochliegend 2/2



SMD, jedoch bastelfreundliche Gehäusegrößen (0805, SOT23, DPAK)

	<b>SPD50P03L G P-FET, -30 V</b>	<b>FDD6637 P-FET, -35 V</b>	<b>SUD50P06-15 P-FET, -60 V</b>	<b>95SQ015 Schottky, 15 V</b>
<b><math>R_{DS,ON}</math> @ 10 V<sub>GS</sub></b>	7.0 mΩ	11.6 mΩ	15.0 mΩ	-
<b>Spannungsabfall bei 5 A</b>	35 mV	58 mV	75 mV	275 mV
<b>Verluste bei 5 A</b>	175 mW	290 mW	375 mW	1375 mW



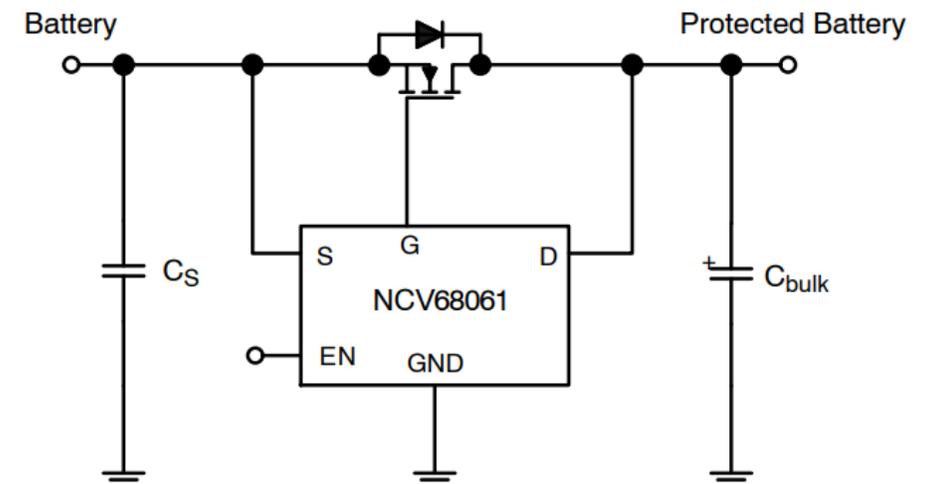
# Exkurs: N-MOSFET hochliegend

***Sehr niederohmige P-MOSFETs für höhere Ströme ( $> 10\text{ A}$ ) nicht auf dem Markt verfügbar***

- Grundlage eines P-MOSFETs ist die Mobilität der Löcher, bei einem N-MOSFET die Mobilität der Elektronen
- Mobilität der Löcher ist fast zweieinhalb mal kleiner als die Mobilität der Elektronen
- Bedeutet für den gleichen Widerstand eine deutlich größere Siliziumfläche im Vergleich bei einem P-MOSFET zu einem N-MOSFET
- Höhere Kosten sowie Limitierungen bezüglich max. Silizium-Größe für Gehäuse (Kosten)

***Lösung: N-MOSFET hochliegend + „Ideal Diode Controller“***

- Beispiel NCV68061
- Integrierte Ladungspumpe
- Misst Spannungsabfall zwischen Source und Drain und schaltet N-MOSFET entsprechend an und aus
- Extrem niederohmige N-MOSFETs ( $< 0.5\text{ m}\Omega$ ) können verwendet werden



# Zusammenfassung

- Wenn Verpolschutz mit Dioden, dann bevorzugt Schottky-Dioden, um die Verluste zu minimieren
- Über 2 A kann / sollte man über die hier gezeigten Alternativen nachdenken
- Bei 5 A spart man mehr als 1 W Verluste ein, wenn eine sehr gute Schottky-Diode durch einen niederohmigen P-MOSFET ersetzt wird
  - Reduziert Erwärmung im Gerät
  - Verlängert ggf. die Betriebsdauer bei Batteriebetrieb
- Artikel erscheint in der CQ DL 6/2023



... es sind noch ein paar unbestückte Leiterplatten übrig

